



ANEXO

Referencia proyecto: SA254P18

Título Proyecto: "Simulación y caracterización de efectos electro-térmicos en dispositivos de subterahercios para comunicaciones de alta velocidad".

Fecha de Publicación convocatoria: 10 de enero de 2019

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 31 de enero de 2019

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León cofinanciada con Fondos FEDER.

Categoría: Investigador/a Posdoctoral.

Jornada semanal: 37.5 horas

Horario: Lunes - Jueves: 9-14 y 16-18,30 Viernes: 8-15,30

Modalidad de Contrato: "Contrato Temporal de Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación"

Número de contratos: 1

Retribución: 12 pagas de 2.530 € mensuales.

Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias / Edificio de I+D+i

Centro, departamento o Instituto: Departamento de Física Aplicada

Fecha prevista de inicio de contrato: 01/04/2019

Fecha prevista de fin de contrato: 31/12/2020

Comisión de Selección:

Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue

Vocal 1: Tomás González Sánchez

Vocal 2: Javier Mateos López

Secretario/a: Ignacio Íñiguez-de-la-Torre Mulas

Objeto del Contrato:

Las tareas fundamentales del investigador serán:

- Caracterización eléctrica (DC y RF) de dispositivos semiconductores en oblea para aplicaciones de sub-THz, incluyendo medidas en función de la temperatura (10-500K) y medidas Hall.
- Simulación circuital y electromagnética de dispositivos y circuitos electrónicos basados en semiconductores para el desarrollo de emisores y detectores de RF y THz: redes de adaptación de impedancias, antenas, cavidades resonantes, módulos de guía de onda, etc.

Otras posibles tareas serán:

- Caracterización en espacio libre de dispositivos a frecuencias de sub-THz.
- Apoyo en la fabricación de dispositivos en sala blanca.

Requisitos específicos:

1. Titulación: Doctor en Ciencias o Ingeniería. Titulación previa en Física, Ingeniería Electrónica o Ingeniería de Telecomunicaciones (o estudios asimilables a éstos).
2. Acreditación en su caso de estancias posdoctorales.

El investigador a contratar no podrá haber leído su tesis doctoral ni haber realizado su trabajo de investigación predoctoral en el mismo organismo que realiza la petición, salvo que se acredite documentalmente una o varias estancias posdoctorales de investigación en una universidad o centro de investigación en el extranjero, que sumen, al menos, 24 meses

3. Otros:

Méritos y valoración de los mismos:

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (60%)
 - Expediente académico de titulaciones de grado y máster (o equivalentes)
 - Publicaciones científicas y patentes
 - Contribuciones en congresos
 - Participación en proyectos de investigación
 - Estancias en centros internacionales
 - Otros méritos

2. Experiencia en Técnicas y Conocimientos Relacionados con el Perfil de la Plaza (40%), especialmente en estos aspectos

- Caracterización eléctrica de dispositivos semiconductores de RF (experiencia en el manejo de analizadores vectoriales de redes, analizadores de espectros, osciloscopios digitales de altas prestaciones, etc.)
- Simulación de dispositivos semiconductores y circuitos de RF y THz. En especial en simuladores HFSS, ADS o análogos.
- Técnicas de fabricación de dispositivos en sala blanca (fotolitografía, litografía por haz de electrones, grabado, etc.).